

05.2; 09

© 1990

ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН ГЕКСАФЕРРИТА БАРИЯ

Ю.Ф. О г р и н, И.И. П е т р о в а,
В.Г. Г а й в о р о н

При исследовании спектра электромагнитных возбуждений в пластинах одноосных ферритов необходимо учитывать тип и параметры реальной доменной структуры (ДС), т.к. размагничивающие поля доменов могут существенно повлиять на вид дисперсионных кривых возбуждаемых волн. Способ теоретического рассмотрения этого влияния в большой степени зависит от соотношения длины волны (λ) и размера доменов (D). Например, в случае $\lambda \gg D$ при расчете спектра магнитостатических волн в пластинах феррита с полосовой доменной структурой (ПДС) использовался метод усреднения тензора магнитной восприимчивости ($\hat{\mu}$) по доменам [1]. На практике величина D зависит от множества факторов и может иметь значения, отличающиеся от случая к случаю на порядки. В работе [2] экспериментально показано, что ДС монокристаллических пластин гексаферрита бария (ГФБ) с легкой осью, нормальной к плоскости, и толщиной 1–20 мкм в зависимости от величины направления внешнего магнитного поля (H) может быть цилиндрической, лабиринтной или полосовой, причем размеры D не превышают нескольких микронов. Для таких пластин условие $\lambda \gg D$ выполняется с большим запасом, т.е. реально возбуждаемые волны (электромагнитного и спинового характера) в пластинах одноосных ферритов в миллиметровом диапазоне СВЧ имеют длину не менее сотен микрон [3]. В настоящее время обозначился интерес исследователей к применению поликристаллических пластин одноосных ферритов в качестве вслноведущих систем в миллиметровом диапазоне длин волн [4]. Данных о доменной структуре таких пластин различной толщины не имеется. Вместе с тем кристаллографическая разориентировка кристаллитов в таких материалах и наличие межкристаллитных границ могут быть определяющими факторами при зарождении ДС.

В данной работе сообщается о результатах наблюдения ДС поликристаллических полированных пластин ГФБ толщиной 0.1–0.7 мм и легкой осью, лежащей в плоскости пластин. Параметры материала: поле анизотропии – ≈ 12.5 кэ, намагниченность насыщения – ≈ 3.2 кГс.

Исследуемые пластины с легкой осью, лежащей в плоскости пластин или нормально к ней, вырезались из шайб ГФБ диаметром 30–40 мм и толщиной ≈ 3 –5 мм, изготовленных по стандартной

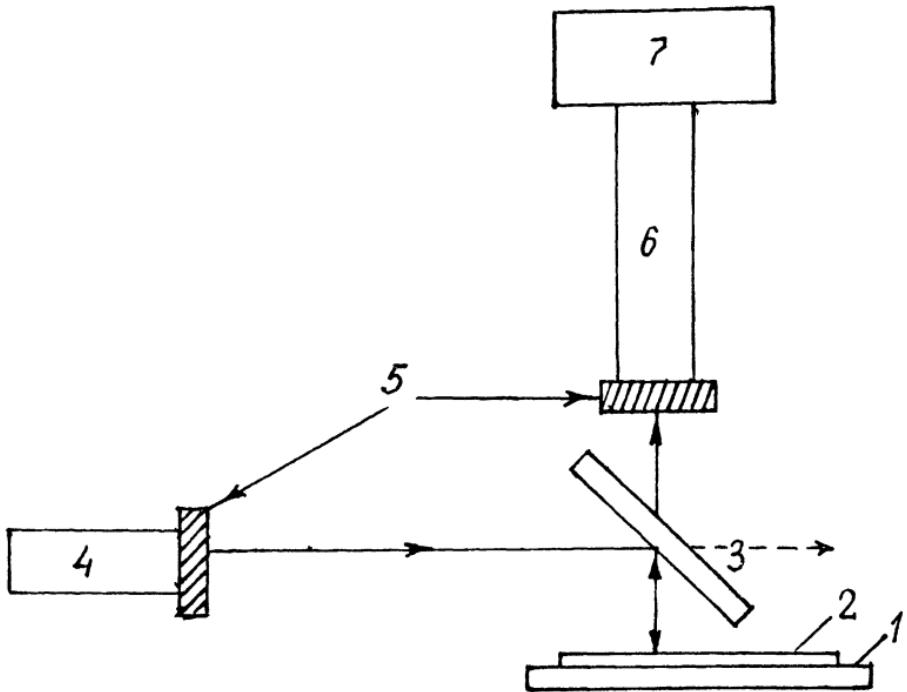


Рис. 1. Схема эксперимента по наблюдению доменной структуры в пластинах гексаферрита бария. 1 - пластина гексаферрита, 2 - висмутодержащая пленка феррит-граната, 3 - полупрозрачное зеркало, 4 - осветитель, 5 - поляроиды, 6 - микроскоп, 7 - фотоаппарат.

технологии получения поликристаллических ферритов. При этом легкая ось шайб была направлена нормально к их плоскости. Кристаллографическая текстура изготовленных шайб составляла 70–80%.

Наблюдение ДС в пластинах ГФБ толщиной 0.1 мм и более непосредственно методом эффекта Фарадея не представляется возможным из-за непрозрачности пластин, поэтому в работе использовался метод магнитооптической визуализации с помощью висмутодержащих пленок феррит-граната [5]. Схема эксперимента показана на рис. 1. Принцип метода заключается в наблюдении наведенной (пластины ГФБ) доменной структуры висмутодержащей пленки феррит-граната, обладающей сильным эффектом Фарадея и достаточной прозрачностью.

На рис. 2 представлена фотография ДС ($H=0$) пластины ГФБ толщиной 0.4 мм. Характерным для образцов такой толщины является полосовой вид ДС (мелкая лабиринтная структура является собственной ДС висмутодержащей пленки). В отличие от классических ПДС монокристаллических ферритовых пластин представленная ПДС не является строгопериодической и имеет значительную неравномерность ширины домена вдоль его длины. Второе отличие



Рис. 2. Доменная структура пластины гексаферрита бария (толщиной 0.4 мм) с легкой осью, лежащей в плоскости пластины. Размер поля зрения поперек полосовых доменов составляет ≈ 3 мм.

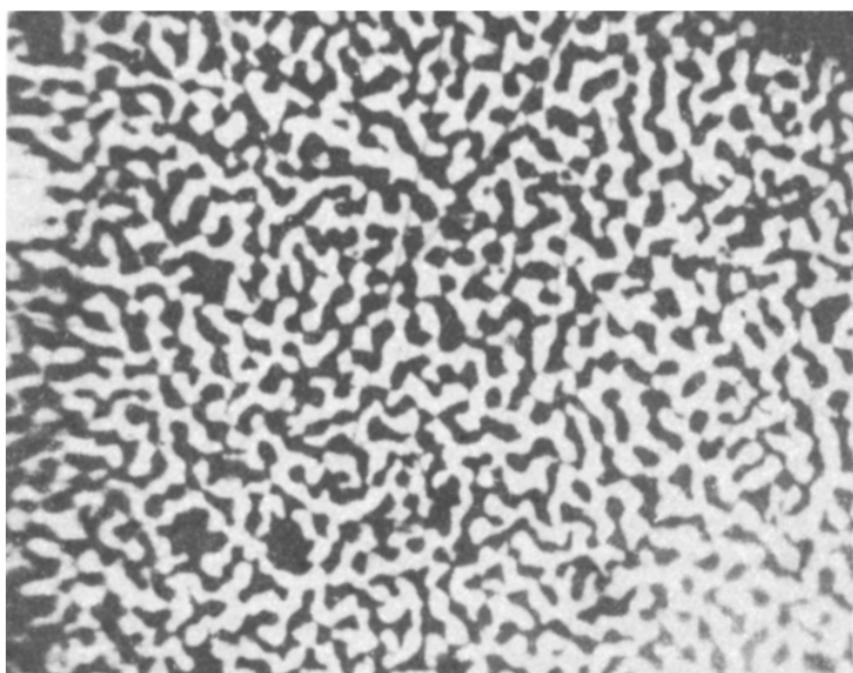


Рис. 3. Доменная структура пластины гексаферрита бария (толщиной 0.4 мм) с легкой осью, нормальной к плоскости.

от случая монокристаллов – большая ширина домена ($D \sim 0.2$ мм). Наблюдаемая доменная структура существенно зависит от толщины пластины ГФБ. Общая картина изменения ДС следующая: при уменьшении толщины пластин величина D сначала слабо меняется, а при толщинах 0.3–0.2 мм полосовой характер ДС начинает исчезать, и при толщинах ≈ 0.1 мм весь образец разбивается на 2–3 области монодоменного состояния. Включение и выключение внешнего поля, направленного вдоль легкой оси, меняет расположение областей монодоменного состояния, но общая картина сохраняется. ДС исчезает полностью при включении поля $H \approx 300$ –500 Э. Доменная структура пластин ГФБ с легкой осью, нормальной поверхности, показана на рис. 3. ДС в этом случае имеет лабиринтный характер, переходящий во многих местах в цилиндрический с $D_x \approx 50$ –60 мкм, что на порядок превышает диаметр цилиндрического домена монокристаллической пластины ГФБ [2].

Наблюдаемые особенности ДС поликристаллических пластин гексаферрита бария – аномально большой размер доменов (по сравнению с ДС монокристаллов), значительное нарушение периодичности доменной решетки и квазимонодоменное состояние пластин при малых толщинах – существенным образом отражаются на спектральных характеристиках СВЧ линий передачи (в миллиметровом диапазоне), содержащих эти пластины. Эти особенности необходимо учитывать в соответствующих теоретических моделях.

Авторы выражают искреннюю благодарность Ф.В. Лисовскому за помощь в проведении эксперимента.

Список литературы

- [1] Зависляк И.В., Данилов В.В. // Письма в ЖТФ. 1982. Т. 8. № 2. С. 72–76.
- [2] Kojima H., Goto K. // J. of Appl. Phys. 1965. V. 36. N 2. P. 538–543.
- [3] Gerson T.J., Nadan J.S. // IEEE Transactions on microwave theory and Techniques. 1974. MTT-22. N 8. P. 757–763.
- [4] Мериакри С.В., Огрин Ю.Ф. 'Тез. докл. XI Всес. школы – семинара „Новые магнитные материалы микроэлектроники”, Ташкент, 1988. Ч. 1. С. 162–163.
- [5] Введенский Б.С., Лисовский Ф.В., Червоненкис А.Я. // Техника кино и телевидения. 1978. № 6. С. 11–16.

Поступило в Редакцию
9 декабря 1989 г.
В окончательной редакции
7 апреля 1990 г.